

物理電子システム創造専攻

平成19年度修士中間発表会プログラム

日程:平成19年6月18日(月)~19日(火)

発表時間:中間 15分=発表8分+質疑7分、進学および博士一貫コース 18分=発表8分+質疑10分、構想 12分=発表6分+質疑6分

6月18日(月) A会場(すずかけホール第一集会室) 10:00~15:20

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会	備考	審査員
10:00	柴田 宏	徳光 永輔	ITOチャンネル強誘電体ゲートトランジスタのメモリ特性に関する研究	坂巻		
10:15	加藤 潤	徳光 永輔	低温堆積膜をゲート絶縁膜に用いたSiCパワー-MOSFETに関する研究			
10:30	佐藤 崇	徳光 永輔	酸化物チャンネル薄膜トランジスタの高性能化に関する研究			
10:45	井上 真理子	梶川 浩太郎	ドライプロセスによる光ファイバ型局在プラズモンバイオセンサ	加藤		
11:00	大野 泰明	梶川 浩太郎	光ナノアンテナによる散乱光測定			
11:15	柴田 大輔	梶川 浩太郎	ドライプロセスで作成した金ナノ微粒子の非線形光学効果			
11:30	鳥井原 匡	梶川 浩太郎	強誘電体液晶の螺旋構造による表面プラズモン励起の測定			
11:45	休憩					
13:00	石井 隆宏	益 一哉	低消費電力オンチップ伝送線路配線の研究	大野		
13:15	大橋 一磨	益 一哉	低雑音・低消費電力RF CMOS発振器に関する研究			
13:30	萩原 汐	益 一哉	LSI電源の統計的解析及び設計手法の研究		進学	益,佐藤,中山, 石原,徳光,前島
13:48	富 万林	益 一哉	高密度多層伝送線路配線の最適化に関する研究			
14:03	福田 聡	益 一哉	広帯域RF CMOS低雑音増幅器の研究			
14:18	休憩					
14:35	多々良 裕基	小林 功郎	波長変換を用いた全光パケット経路スイッチ網に関する研究	石井		
14:50	野口 博和	小林 功郎	波長ビット転写による光シリアル・パラレル変換に関する研究			
15:05	坂巻 常治	小林 功郎	面型変調器を用いた高速高密度光インターコネクション用光源に関する研究			

6月18日(月) B会場(すずかけホール第二集会室) 10:00~15:15

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会	備考	審査員
10:00	川那子 高暢	岩井 洋	A Study on Complex High-k Gate Oxides for Improving Mobility	辰尾	進学	
10:18	佐藤 創志	岩井 洋	Effects of Nitrogen Incorporation into La2O3 Gated MOSFET using Nitrogen Radicals		進学	
10:36	足立 学	岩井 洋	A Novel Effective Work Function Control for Metal/High-k Gate Stack using Composite Oxides			
10:51	両角 康宏	岩井 洋	Analysis of Quasi Ballistic Calculation using RT Model in Advanced MOSFET			
11:06	大石 善久	岩井 洋	Effective Work Funktion Control Using Metal Additive for Ni Silicide Schottky Barrier MOSFET			
11:21	佐藤 峰斗	伊藤 治彦	近接場光レンズを用いた原子のナノフォーカシングに関する研究	足立		
11:36	栗田 昌尚	伊藤 治彦	2軸bow-tie構造を用いた原子の近接場光トラップに関する研究			
11:51	休憩					
13:00	仲野 雄介	大見 俊一郎	ECRプラズマプロセスによる極薄HfO2系ゲート絶縁膜の形成とデバイス応用	栗田		
13:15	高 峻	大見 俊一郎	せり上げPtSiサリサイドにおける仕事関数制御とSOI-MISFETへの応用			
13:30	野武 幸輝	大見 俊一郎	SBSIプロセスによるSOI/BOX層の均一形成に関する検討			
13:45	澤田 憲吾	植之原 裕行	光ラベル識別器に向けた、光D/A変換器の特性向上と半導体集積化に関する研究	仲野	構想	
13:57	鈴木 昌弘	植之原 裕行	光信号誤り訂正技術に関する研究			
14:12	休憩					
14:30	竹内 淳	浅田 雅洋	二次元電子ガスを用いた半導体クライストロンに関する研究	鈴木 昌		
14:45	岸本 直道	浅田 雅洋	共鳴トンネルダイオードテラヘルツ発振素子のスペーサ層による高周波化			
15:00	辰尾 佳彦	浅田 雅洋	ショットキーバリアダイオードと広帯域アンテナを用いたTHz帯検出素子に関する研究			

6月19日(火) A会場(すずかけホール第一集会室) 10:00 ~ 15:15

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会	備考	審査員
10:00	絹川 大	谷・半那	電極/液晶性有機半導体界面の電子構造とキャリア注入機構の解明	小川		
10:15	塩見 晋章	半那 純一	液晶性有機半導体を用いた有機EL素子の研究			
10:30	下平 善樹	半那 純一	反応性熱CVD法による多結晶薄膜の大面积化			
10:45	常多 真那美	高田・半那	液晶性有機半導体ポリマーの合成と電気特性評価			
11:00	中村 司	半那 純一	液晶性有機半導体の電荷輸送に与えるダイポールの影響			
11:15	細井 勉	半那 純一	反応性熱CVD poly-SiGe大面积薄膜の特性向上			
11:30	黒木 圭介	小山 二三夫	低光群速度光伝搬を利用した小型光変調器に関する研究	絹川		
11:45	竹石 知史	小山 二三夫	ナノインプリント技術を用いた中空導波路光デバイスの研究			
12:00	休憩					
13:00	渡邊 敬仁	筒井 一生	ドライプロセスによる弗化物共鳴トンネルダイオードとSi-MOSFETのモノリシック集積化の研究	黒木		
13:15	大川 峰司	筒井 一生	弗化物共鳴トンネルダイオードにおける特性不安定現象の解明と安定化策の研究			
13:30	渡邊 将光	筒井 一生	プラズマドーピングで形成したp+極浅領域のキャリア活性化に関する研究			
13:45	休憩					
14:00	行田 裕一	宗片 比呂夫	Fe-GaAs系円偏光発光素子の作製と評価	大川		
14:15	野村 健太	宗片 比呂夫	走査型磁気光学顕微鏡による光誘起磁化の研究			
14:30	能政 広毅	宗片 比呂夫	InMnAs多層膜構造の作製と評価			
14:45	鎌水 将志	宗片 比呂夫	強磁性半導体を活用した直線偏光検出素子の作製と評価			
15:00	小川 悠介	宗片 比呂夫	強磁性体・半導体ハイブリッド構造光デバイスのためのMnSb薄膜の成長と評価			

6月19日(火) B会場(すずかけホール第二集会室) 10:00 ~ 15:15

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会	備考	審査員
10:00	安念 一規	石原 宏	C60フラーレンを用いた強誘電体ゲートトランジスタの作製と評価	和田		
10:15	岡沢 昂	石原 宏	Bi ₂ WO ₉ Mn _{0.1} O ₆ 等の低比誘電率強誘電体材料のMFISデバイスへの適用			
10:30	高下 裕一郎	石原 宏	強誘電体ゲートカーボンナノチューブトランジスタの作製と評価			
10:45	李 月剛	石原 宏	2T型強誘電体メモリの作製及び評価に関する研究			
11:00	池田 武嗣	有本・石原	MFIS-FETを用いたNAND型FeRAMのディスタープに関する研究			
11:15	仁科 友宏	宮本 智之	アレイレーザを用いた時空間位同期レーザに関する研究	岡沢		
11:30	中島 浩	宮本 智之	トンネル注入レーザの発振メカニズム解明と動作特性向上に関する研究			
11:45	近森 峻	納富 雅也	フォトニック結晶結合共振器による光制御の研究			
12:00	休憩					
13:00	大石 真	青柳 克信	深紫外LEDのための高品質AlGaIn層作製に関する研究	仁科		
13:15	大塚 匠	青柳 克信	深紫外LEDの外部量子効率向上に関する研究			
13:30	前川 倫宏	青柳 克信	高効率化に向けた深紫外LEDの縦型化に関する研究			
13:45	巻幡 光俊	青柳 克信	カーボンナノチューブ量子ドット多機能化に向けた化合物半導体とのハイブリッド化に関する研究			
14:00	休憩					
14:15	桑井 正也	渡辺 正裕	CdF ₂ /CaF ₂ サブバンド間遷移レーザに向けた素子構造形成に関する研究	大塚		
14:30	鈴木 雄介	渡辺 正裕	Si基板上弗化物系共鳴トンネルダイオードを用いた集積構造形成に関する研究			
14:45	藤久 雄己	渡辺 正裕	CdF ₂ /CaF ₂ サブバンド間遷移レーザに向けた高品質活性層に関する研究			
15:00	和田 宇史	渡辺 正裕	弗化物系共鳴トンネル構造を用いた3端子集積デバイスに関する研究			